



Toshiba lancia due nuovi MOSFET a canale N da 80V

Fabbricati in processo U-MOSX-H, i nuovi dispositivi miglioreranno significativamente l'efficienza degli alimentatori

Düsseldorf, Germania, 30 Marzo 2020 – Toshiba Electronics Europe (“Toshiba”) ha lanciato due nuovi MOSFET a canale N da 80V fabbricati nel processo di ultima generazione U-MOSX-H dell’azienda. Entrambi i dispositivi sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di alimentazione in cui è essenziale garantire perdite minime durante il funzionamento. Queste ultime includono la conversione AC-DC e DC-DC ad alta efficienza nei data center e nelle stazioni base di comunicazione e un'ampia gamma di soluzioni per l'azionamento dei motori.

Entrambi i dispositivi, siglati TPH2R408QM e TPN19008QM, sono fabbricati in processo U-MOSX-H da 80V, il quale offre una riduzione di circa il 40% della resistenza di on al drain-source ($R_{DS(ON)}$) rispetto ai prodotti da 80V corrispondenti realizzati in processi di generazione precedente come U-MOSVIII-H. Di conseguenza, il TPN19008QM presenta un valore di $R_{DS(ON)}$ di 19mΩ (massimi), mentre il valore di $R_{DS(ON)}$ del TPH2R408QM è di appena 2,43 mΩ.

L'ottimizzazione della struttura del dispositivo ha migliorato il compromesso tra il valore di $R_{DS(ON)}$ e le caratteristiche di carica del gate anche del 15% e il compromesso tra $R_{DS(ON)}$ e la carica in uscita del 31%. Combinando questi risultati con la riduzione della $R_{DS(ON)}$, si ottiene con i nuovi dispositivi la dissipazione di potenza più bassa nel settore.

Entrambi i dispositivi sono alloggiati in package a montaggio superficiale e presentano una tensione di drain source (V_{DSS}) massima di 80V. Possono operare con temperature di canale (T_{ch}) fino a 175°C. Il TPN19008QM è caratterizzato da una corrente di drain (I_D) di 34A ed è alloggiato in un package TSON avanzato da 3,3 mm x 3,3 mm mentre il TPH2R408QM offre una I_D di 120A ed è alloggiato in un package SOP avanzato da 5,0 mm x 6,0 mm.

La consegna progressiva dei nuovi dispositivi ha inizio da oggi.

Per maggiori informazioni sulla linea di MOSFET da 12-300V di Toshiba seguite il link qui sotto.

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/mosfet/lv-mosfet.html>

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki Kumagai.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0) 1932 822 832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 1582 390980

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Marzo 2020

Rif. 7251